



## منابع تغذیه پالسی در لیزرهای بخار مس

داود صالحی نیا\*

مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۸۴۸۶-۱۱۳۶۵، ایران - تهران

**چکیده:** منابع تغذیه‌ای که به طور متدال در لیزرهای پالسی با ساز و کار داشت الکتریکی بکار می‌روند در واقع نوعی دستگاه مولده پالس هستند. این دستگاهها به علت کاربردهای وسیعشان به ویژه در لیزرهای پالسی از اهمیت خاصی برخوردارند. در این کار پژوهشی، ویژگیهای یک دستگاه منبع تغذیه پالسی که در لیزرهای بخار فلزی از جمله لیزر بخار مس بکار برده می‌شود مورد بحث قرار گرفته است. طراحی مدار، ساخت و اندازه‌گیری پارامترهای بکار رفته نیز ارائه شده‌اند. پیشنه ولتاژ خروجی سیستم  $10 \text{ kV}$ ، پهنای پالس تقریباً  $1\mu\text{s}$  و شدت جریان متوسط  $340 \text{ mA}$  است. آنکه تکرار پالس منبع تغذیه نای ۲۹ کیلوهرتز قابل تغییر است.

**واژه‌های کلیدی:** منبع تغذیه، لیزر بخار فلزی، لیزر بخار مس

## Pulsed Power Supplies in CVL Lasers

D. Salehinia\*, K. Khorasani

Laser Research Center, AEOI, P.O.Box:11365- 8486, Tehran - Iran

**Abstract:** Power supplies which are commonly used in pulsed lasers with the mechanism of electrical pumping are in fact a kind of pulse generator. These systems are of particular importance due to their wide variety of applications, and their use in pulsed lasers are the most important subject of interest. In this article specifications of a pulsed generator which is designed for metal vapor lasers such as CVL lasers will be introduced. Details of the designed circuit, construction, and measurements of the working parameters will be also presented. The maximum output voltage is  $10 \text{ kV}$  with the pulse width of  $\sim 1\mu\text{s}$ . The average current is  $340 \text{ mA}$  and the pulse repetition rate is  $29 \text{ kHz}$ .

**Keywords:** power supply, metal vapor laser, CVL laser



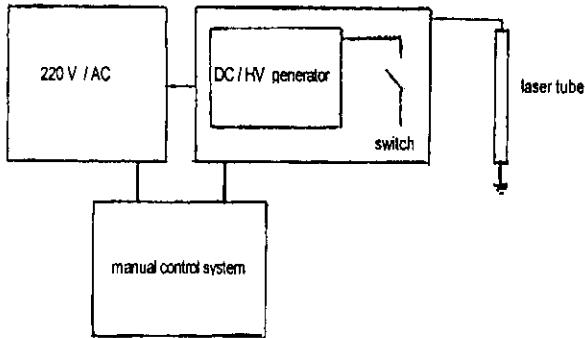
~۱۷۰۰ V/μs

### شبیه فروافت ولتاز

در طراحی منع تغذیه ای با مشخصات پیش‌گفته لازم است به عوامل مهم دیگری مانند بازدهی دستگاه، حجم آن و قیمتی که تمام می‌شود نیز توجه داشت.

### ۲- اساس کار منابع تغذیه لیزرهای بخار فلزی

اساس کار منابع پالسهای الکتریکی با ولتاژ زیاد و بسامد نسبتاً بالا را می‌توان چنین بیان کرد: توسط یک دستگاه مبدل AC به DC، شامل ترانسفورماتور افزاینده و مدار یکسوکنده، خط ولتاژ DC تولید می‌شود سپس این ولتاژ به وسیله یک کلید الکترونیکی روی دو سرلوه لیزر کلیدزنی می‌شود (شکل ۱).



شکل ۱- ساختار اساسی منع تغذیه پالسی

بنابراین در آغاز کار می‌توان این دستگاه را به سه قسمت شامل سیستم کنترل دستی (کلیدها، فیوزها و نشانگرها)، کلید الکترونیکی و منع تغذیه DC تقسیم بندی نمود. قسمت اول همانند سیستمهای کنترلی و نظارتی رایج است و از پرداختن به جزئیات آن صرف نظر می‌شود.

### ۳- کلید الکترونیکی

این کلید باید با آهنگ تکرار زیاد (در محدوده ۵ تا ۲۵ کیلوهرتز) و در مدت کوتاهی، حدود چند میکرو ثانیه، عمل کلیدزنی را انجام دهد. شاید بتوان گفت که مناسب‌ترین کلید با چنین ویژگیهایی لامپ تایراترون<sup>(۱)</sup> است. اساس کار این لامپ در حالت اتصال بر پایه ایجاد تخلیه الکتریکی در گاز هیدروژن قرار دارد. لامپ باید توسط سیستمی تحت کنترل و فرمان قرار گیرد یا به

### ۱- مقدمه

لیزرهای بخار فلزی به لحاظ نوع محیط فعالشان، جزو لیزرهای گازی محسوب می‌شوند [۲۶]. محیط فعال این نوع لیزرها، همانطور که از نامشان برمی‌آید، بخاریک فلز است. تبخیر فلز به روشهای گوناگون صورت می‌گیرد، از جمله: حرارت دادن مستقیم فلز، بباران فلز به وسیله باریکه‌های الکترونی، همچنین گرم کردن آن به روش ایجاد تخلیه الکتریکی در یک گاز کمکی مانند هلیوم یا نون که بیشتر مورد توجه است. چنانچه لیزرها بر حسب نوع سیستم دمک طبقه بندی شوند جزو لیزرهای با دمک الکتریکی پالسی دسته‌بندی می‌گردند. با توجه به نوع محیط فعال و خواص فیزیکی فلز بکار رفته، مانند مشخصات ترازهای انرژی که در فرایند لیزری دخالت دارند، همچنین مشخصات و ابعاد کاواک لیزری، پالسهای مورد نیاز مشخصات خاصی دارند [۲۶]. در بعضی از لیزرهای بخار فلزی، مانند لیزرهای نمک فلزی، فرایند تشکیل محیط فعال، یعنی اتمهای فلز مورد نظر، با تبخیر نمک آن فلز و تشکیل بخار حاوی مولکولهای آن، سپس شکستن این مولکولها و جدا شدن اتمهای فلز از نمک انجام می‌گیرد. بنابراین، دو پالس مورد نیاز است: پالس اول مولکولهای نمک را شکسته و اتمهای فلز را آزاد می‌کند و پالس دوم عمل تحریک و فرایند لیزری را انجام می‌دهد [۳].

مشخصات لیزرهای بخار فلزی به ویژگیهای فیزیکی اتمهای فلز مربوط، مانند فاصله انرژی ترازهای بالایی و پایینی لیزر و مدت توقف الکترونها در این ترازها و همچنین به سیستم محیط فعال گازی و مشخصات آن مانند فشار، دما، حجم، برخورد ذرات تشکیل‌دهنده محیط فعال با یکدیگر و دیواره‌های لوله و ابعاد کاواک تشید کننده بستگی دارد [۲۶]. بنابراین قبل از طراحی و ساخت منع تغذیه آنها باید مشخصات پالسهای مورد نیاز، ازجمله ولتاژ، زمان فروافت، بسامد تکرار پالسها و غیره مشخص شود. بعنوان مثال، پاره‌ای از پالسهای الکتریکی مورد استفاده در فرایند دمک یک نوع از لیزرهای بخار مس به شرح زیر است:

۵ kV

~1 μs

~ ۲۰ kHz

۰ / ۳ μs

۰ / ۳ μs

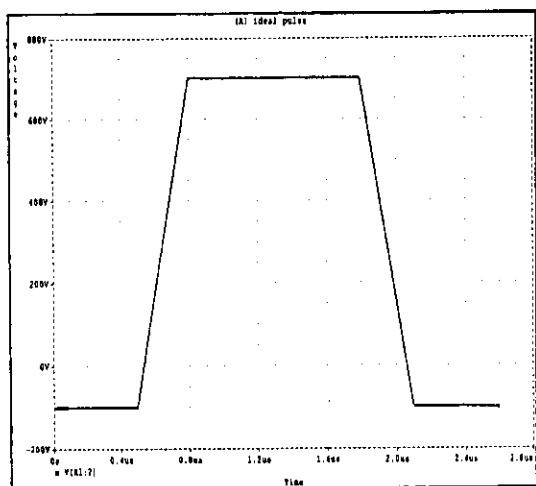
قله ولتاژ آنود لوله

پهنهای پالس ولتاژ

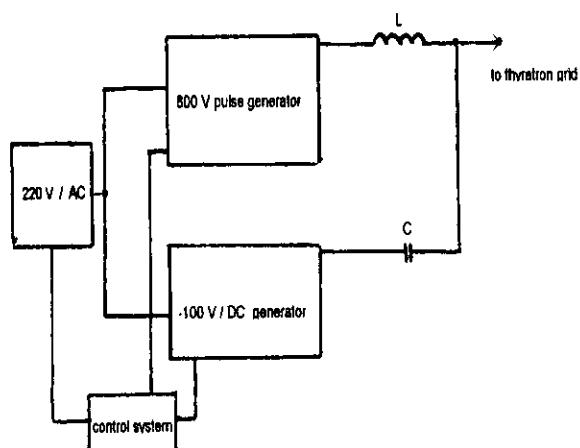
بسامد

زمان فروافت

زمان اوج  
www.SID.ir



شکل ۲- پالس تریگر



شکل ۳- مدلی از مدار مولڈ بالسهای تریگر همراه با بیاس منفی

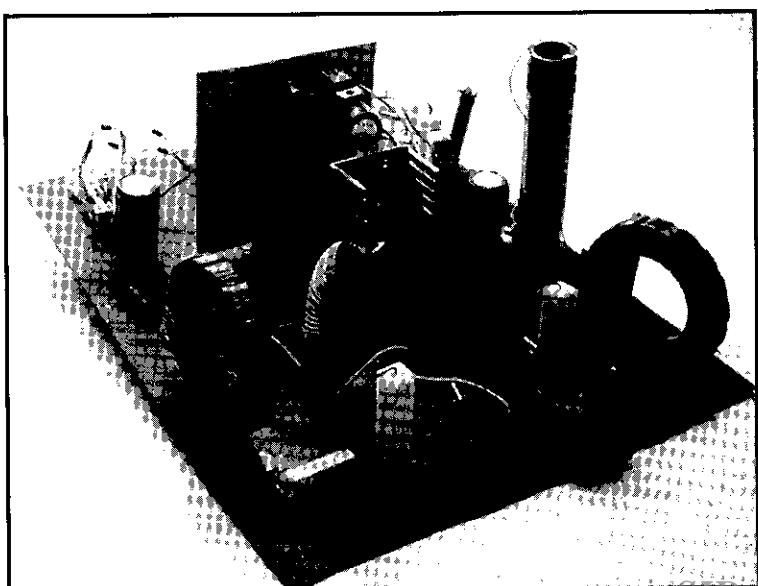
اصطلاح آتش شود. بنابراین مداری به عنوان مدار فرمان یا تریگر<sup>(۴)</sup> لازم است تا از طریق اعمال بالسهایی به پایه فرمان<sup>(۳)</sup> تایراトرون عمل کلید زنی آنرا کنترل کند<sup>[۵]</sup>. مشخصات بالسهای تریگر بستگی به نوع و مدل تایراトرون بکار رفته دارد به عنوان مثال بعضی از مشخصات بالسهای لازم برای راه اندازی مدلی از تایراトرون عرضه می شود:

۵۰۰-۱۲۰۰V	فله ولتاژ
۳- ۷µs	پهنهای پالس ولتاژ
~ ۵۰ k Hz	بسامد
۱۷۰۰ V / µs	شبیب فروافت پالس ولتاژ
~ ۱۰ A	فله شدت جریان

پس از وصل شدن تایراトرون معمولاً لازم است با اعمال بایاس معکوس سریعاً آنرا به حالت قطع باز گرداند، ولتاژ بایاس معکوس حدود ۱۰۰V است. بالسهای فرمان مورد نیاز برای تایراトرون در شکل ۲ نشان داده شده‌اند.

شکل ۳- طرح کلی مداری را که با آن می‌توان بالسهای را تولید کرد نشان می‌دهد. مدل طراحی شده نیز در شکل ۴ نشان داده شده است.

در این طرح و در بخش مولڈ بالسهای ۸۰۰V، از یک مدار مولڈ بالسهای ۱۲V که در آن "LM331" بکار رفته است استفاده می‌شود بطوری که پهنهای بالسهای تولید شده در آن، به وسیلهٔ مدار مشتق گیر تا اندازهٔ مورد نظر تنظیم می‌شود و از این بالسهای برای راه اندازی یک کلید، مانند SCR<sup>(۶)</sup> یا IGBT<sup>(۵)</sup> استفاده

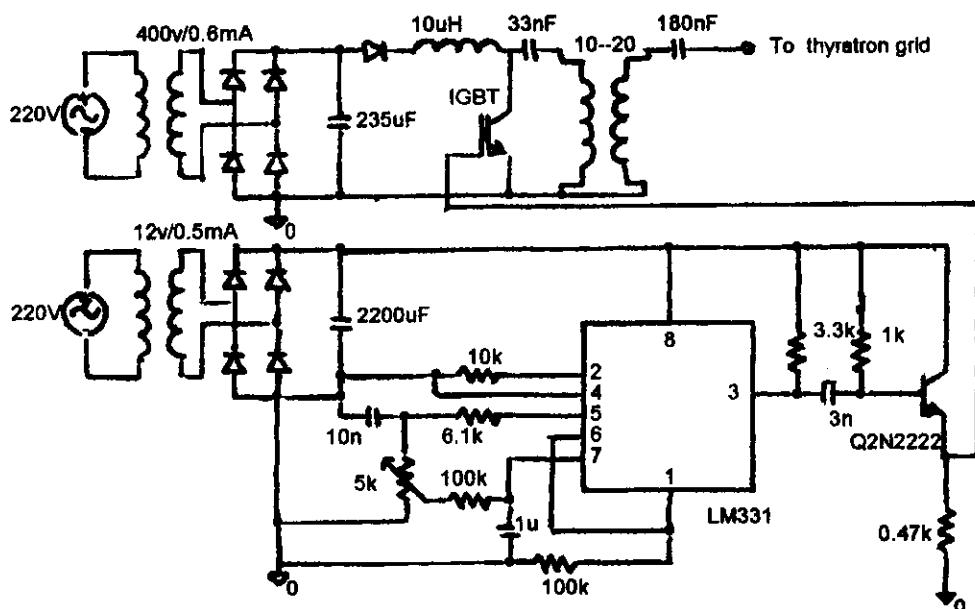


شکل ۴- مدل تریگر طراحی شده

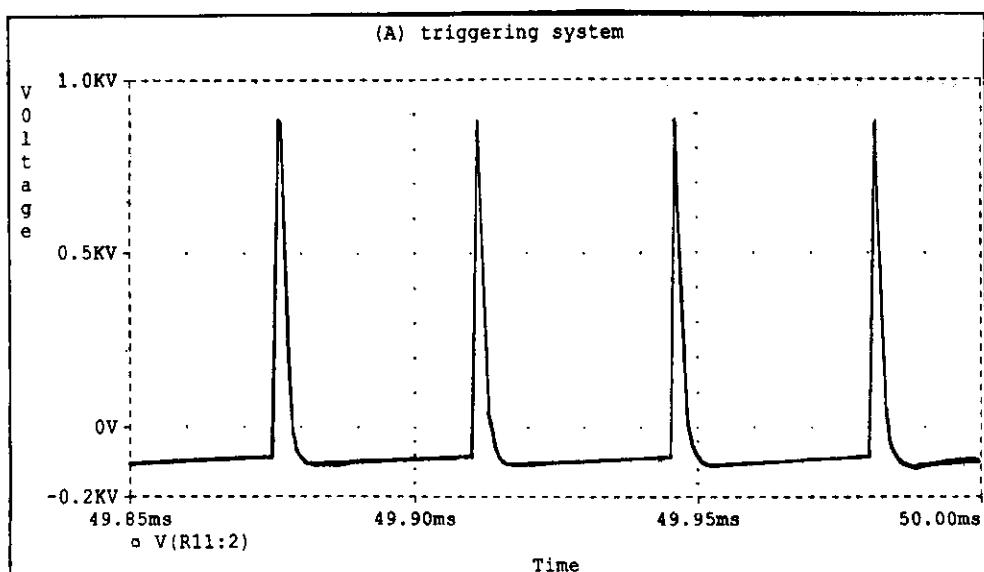


نمونه‌ای از پالسهای مدار فرمان طراحی شده، که توسط نرمافزار Spice تحلیل گردیده، در شکل ۶ نشان داده شده است. پالسهای حاصل از مدار طراحی شده در حالت بدون بار در شکل ۷ و پالسهای این مدار در حالت اتصال به تایروترون در شکل ۸ نشان داده شده‌اند.

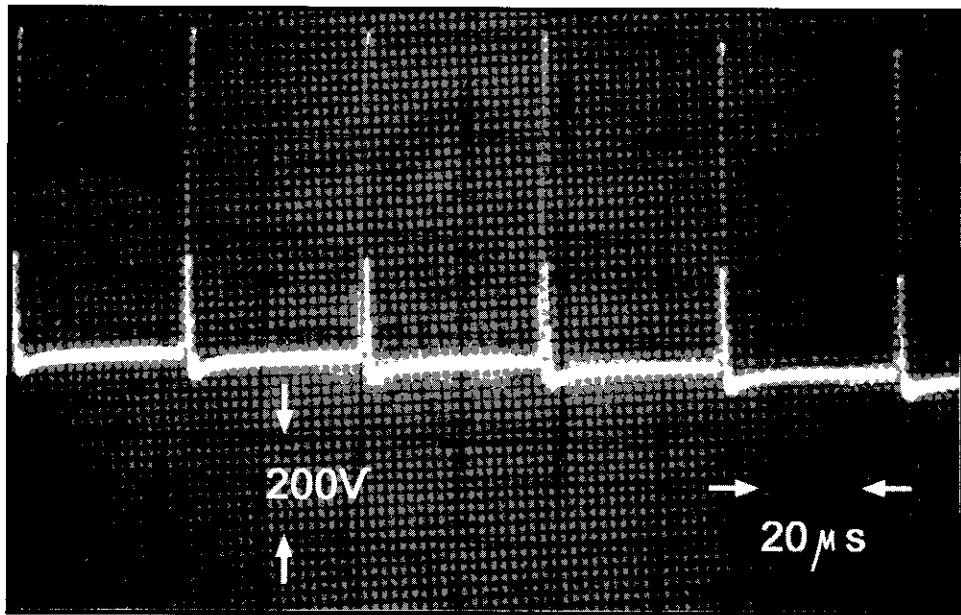
می‌گردد. این کلید ولتاژی در حدود ۴۰۰V.DC را کلیدزنی می‌کند و در نتیجه، پالسهای با ولتاژ تقریباً ۴۰۰V تولید می‌شوند. طرح کلی این مدار در شکل ۵ نشان داده شده است. ترانسفورماتور پالس این مدار دارای هسته فریتی است که ولتاژ ۴۰۰V پالسهای تولید شده را تا حدود ۸۰۰V بالا می‌برد.



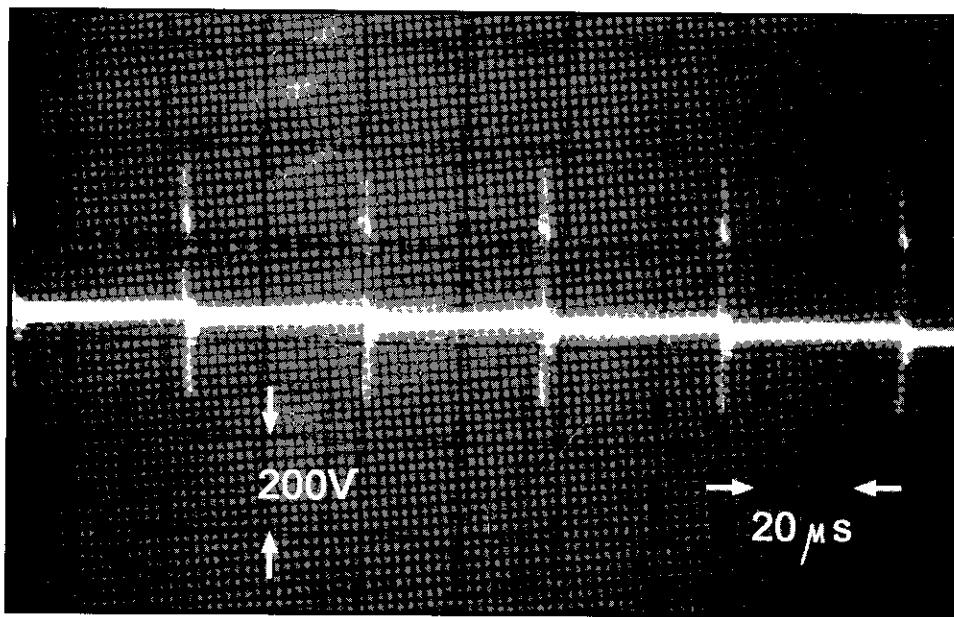
شکل ۵- مدار مولد پالس تریگر بدون بایاس معکوس



شکل ۶- نمونه‌ای از پالسهای مدار فرمان



شکل ۷- بالهای ولتاژ حاصل از مدار تریگر طراحی شده در حالت بدون بار.



شکل ۸- بالهای ولتاژ حاصل از مدار تریگر طراحی شده در حالت اتصال به تایروترون.

کردن حجم سیستم و قیمت تمام شده آن کافی است در بخش مدار DC، ولتاژی در حدود نصف ولتاژ مورد نظر تولید و با استفاده از مدارهای دیودی آنرا دو برابر کرد. طرح کلی این

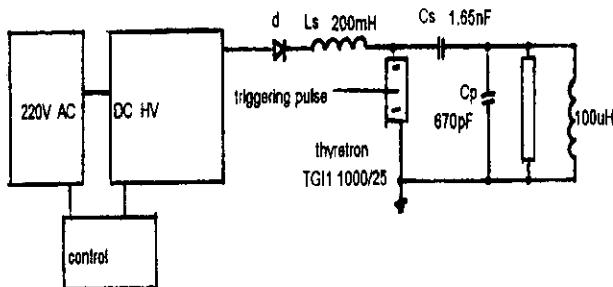
### DC- منبع

با استفاده از مدارهای دیودی و روشهایی مانند آن می‌توان، ولتاژ را تا حدود دو برابر افزایش داد. بنابراین برای کم



پالسهای تریگر تغییر داد.

در جدول ۱ بعضی از مشخصات این مدار با تریگر موجود در منبع تغذیه مدل ۲۰ CVL ساخت کشور چین مقایسه شده است.



شکل ۹- طرح کلی مدار باردار کردن و تخلیه

جدول ۱ - مقایسه پاره‌ای از مشخصات مدار تریگر طراحی شده با مدار تریگر مورد استفاده در منبع تغذیه ۲۰ CVL ساخت کشور چین.

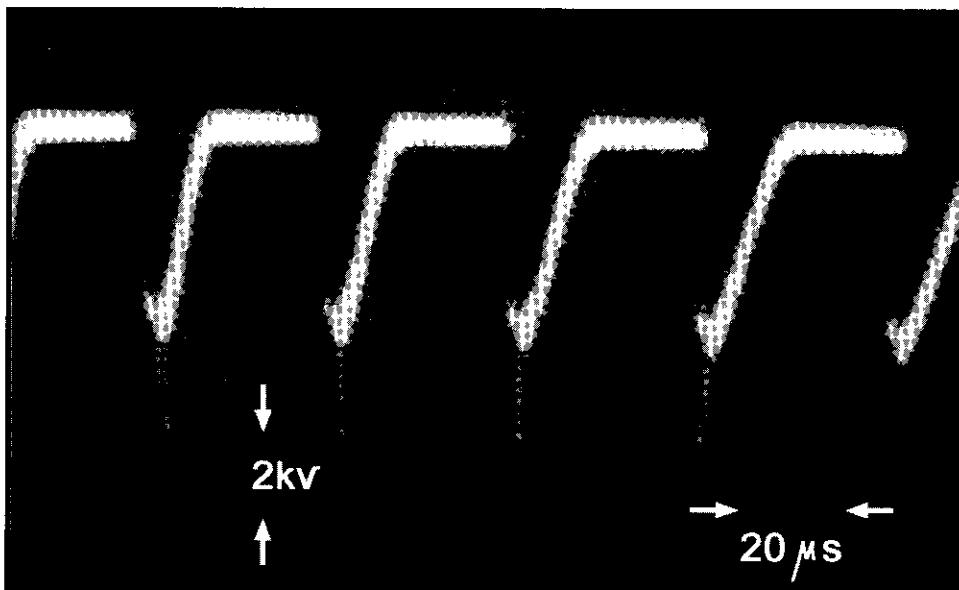
مشخصات مدارها		
مدار تریگر طراحی شده	مدار تریگر ساخت چین	بسامد کار (kHz)
SCR و تایروترون کوچک	IGBT	کلید الکترونیکی
۳	۰/۰-۳	نهانی پالس ( $\mu s$ )
۷۰×۵۰×۲۲	۲۸×۲۲×۱۲	ابعاد مدار (cm) (ارتفاع×عرض×طول)

قسمت در شکل ۹ نشان داده شده است.

$C_{\text{S}}$  خازن ذخیره‌سازی و  $C_{\text{P}}$  خازن باریک کننده<sup>(۴)</sup> پالس است. این مدار در واقع شامل دو مدار باردار کردن و تخلیه است که در مرحله باردار کردن خازن  $C_{\text{S}}$  شارژ می‌شود و در مرحله تخلیه خازن  $C_{\text{P}}$  از طریق  $L_{\text{S}}$  (قبل از شروع تخلیه الکتریکی) و یا در لوله (بعد از شروع تخلیه الکتریکی) تخلیه می‌گردد. در شکل ۱۰ پالسهای ولتاژ آند تایراترون نشان داده شده است.

#### ۴- بحث و نتیجه گیری

ویژگی منبع تغذیه‌ای که در آزمایشگاه لیزر بخار مس "مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر" ساخته شده این است که طراحی آن به طور کامل در این آزمایشگاه انجام گرفته و تمام قطعات بکار رفته در آن نیز از بازار داخلی کشور تهیه شده است؛ در نتیجه، قیمت تمام شده آن مناسب می‌باشد و بخش تریگر آن را می‌توان به عنوان دستگاه مادر در راه اندازی انواع مختلف تایراترونها بکار برد، زیرا دامنه بسامد آن تا ۲۹ KHz است و سایر مشخصات آن نیز برای انواع تایراترون‌هایی که در لیزرهای بخار مس بکار می‌روند مناسب دارد. همچنین، بیشتر بخش‌های دستگاه، قبل از ساخته شدن، به وسیله نرم افزارهایی مانند Mathcad و Pspice تجزیه و تحلیل شده‌اند. علاوه بر این، بنا به نیازمی توان بعضی از مشخصات دستگاه را با انجام تغییراتی، از جمله تغییر پهنه‌ای پالس و تغییر زمان صعود



## پی‌نوشت‌ها:

✓-thyrotron

✓-trigger

✓-gate

✓-silicon controlled rectifier

✓-insulated gate bipolar transistor

✓-sharpening capacitor

## References:

1. W. T. Walter ,N. Soltimene, M. Piltch, "Efficient pulsed gas discharge lasers," IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. QE-2, No.9, 474 (1966).
2. J. T. Verdeyen, Laser Electronics, 2<sup>nd</sup> edition, Prentice – Hall International, Inc, 305-360 (1989).
3. A. A. Vetter, "Quantitive effect of initial current rise on pumping the double pulsed copper chloride laser," IEEE Jornal of Quantum Electronics, Vol. QE-13, No.11, 889 (1977).
4. L. J. Kieffer, "A compilation of electron collision cross section data for modeling gas discharge laser," JILA Information Center Report Sep, No.13 (1973).
5. K. G.Rischmuller, "Switching with MOSFET's and IGBT's, 50 Hz to 200 kHz," Conf. Record 1990, PCIM Europe Conf. (1990).
6. P. A. Bokhan, V. A. Gerasimov, "Optimization of the excitation condition in a copper vapor laser," Sov. J. Quantum Electron. Vol.8, No.3, 273 (1979).